

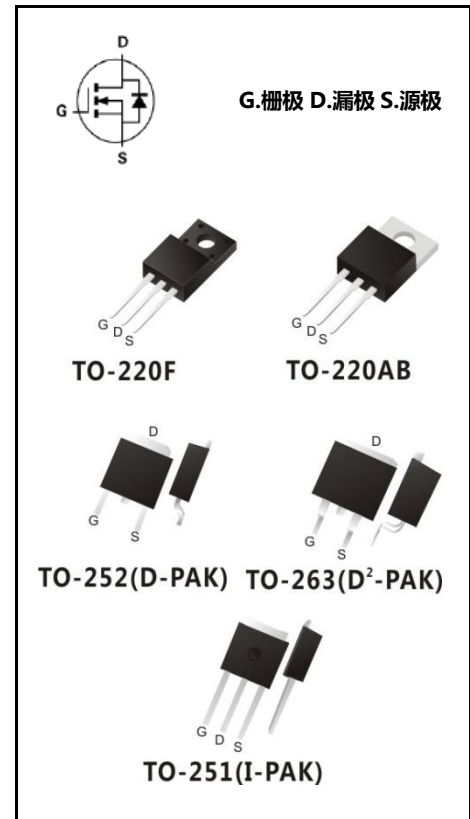
**8A 500V N沟道增强型场效应管**

**主要参数：**

<b>I<sub>D</sub></b>	8A
<b>V<sub>DSS</sub></b>	500V
<b>R<sub>DS(on)-typ(@V<sub>GS</sub>=10V)</sub></b>	0.63Ω

**性能特点：**

- ◆开关速度快
- ◆低导通电阻
- ◆低反向传输电容
- ◆低栅极电荷量
- ◆100%单脉冲雪崩能量测试
- ◆提升了dv/dt能力



**机械性能：**

- ◆注塑成型封装
- ◆适用任何位置安装
- ◆封装材料符合UL 94V-0燃烧防火等级标准
- ◆加工焊接峰值最高温度 275°C ；时间不大于 10s
- ◆封装形式: TO-220AB, TO-220F, TO-263, TO-252, TO-251

**产品规格分类：**

产品料号	封装形式	产品印字	包装方式
YFW8N50A1	TO-220AB	8N50AT	50PCS每管
YFW8N50A2	TO-220F(0.5mm)	8N50AF	50PCS每管
YFW8N50A3	TO-263	8N50AS	50PCS每管
YFW8N50A3-R	TO-263	8N50AS	800PCS每盘
YFW8N50A4	TO-251	8N50AMJ	75PCS每管
YFW8N50A5-R	TO-252	8N50AD	2500PCS每盘

## 极限参数:(除非特殊说明, $T_c=25^{\circ}\text{C}$ )

参数名称	符号	参数范围			单位
		220AB	220F	263	
漏源电压	$V_{DS}$	500			V
栅源电压	$V_{GS}$	$\pm 30$			V
漏极电流-持续	$I_D$	8			A
漏极脉冲电流(注 1)	$I_{DM}$	32			A
耗散功率	$P_D$	100	35	100	W
单脉冲雪崩能量(注 1)	$E_{AS}$	440			$m_j$
工作结温范围	$T_J$	150			$^{\circ}\text{C}$
贮存温度范围	$T_{STG}$	-55 to +150			$^{\circ}\text{C}$
芯片对管壳热阻	$R_{\theta JC}$	1.25	3.57	1.25	$^{\circ}\text{C/W}$
芯片对环境的热阻	$R_{\theta JA}$	62.5	62.5	62.5	$^{\circ}\text{C/W}$

## 电气参数:(除非特殊说明, $T_c=25^{\circ}\text{C}$ )

参数名称	测试条件	符号	最小值	典型值	最大值	单位
漏源击穿电压	$V_{GS} = 0\text{ V}, I_D = 250\ \mu\text{A}$	$BV_{DSS}$	500	540	-	V
漏源击穿电流	$V_{DS} = 500\text{ V}, V_{GS} = 0\text{ V}$	$I_{DSS}$	-	-	1	UA
栅源漏电流	$V_{GS} = \pm 30\text{ V}, V_{DS} = 0\text{ V}$	$I_{GSS}$	-	-	$\pm 100$	nA
栅极开启电压	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = 250\ \mu\text{A}$	$V_{GS(th)}$	2	-	4	V
导通电阻	$V_{GS} = 10\text{ V}, I_D = 4\text{ A}$	$R_{DS(on)}$	-	0.63	0.85	$\Omega$
正向跨导	$V_{DS} = 15\text{ V}, I_D = 4\text{ A}$	$g_{fs}$	-	7	-	S
输入电容	$V_{GS} = 0\text{ V}, V_{DS} = 2\text{ V}, f = 200\text{KHz}$	$C_{iss}$	-	1320	-	pF
输出电容		$C_{oss}$	-	110	-	
反向传输电容		$C_{rss}$	-	7	-	
开启延迟时间(注 2)	$I_D = 8\text{ A}, V_{DD} = 250\text{ V}, R_G = 10\Omega$	$t_d(ON)$	-	18	-	nS
开启上升时间(注 2)		$t_r$	-	20	-	
关断延迟时间(注 2)		$t_d(OFF)$	-	44	-	
关断下降时间(注 2)		$t_f$	-	15	-	
栅极电荷量(注 2)	$I_D = 8\text{ A}, V_{DD} = 400\text{ V}, V_{GS} = 10\text{ V}$	$Q_G$	-	22	-	nC
栅极-源极电荷量(注 2)		$Q_{GS}$	-	5	-	
栅极-漏极电荷量(注 2)		$Q_{GD}$	-	9	-	

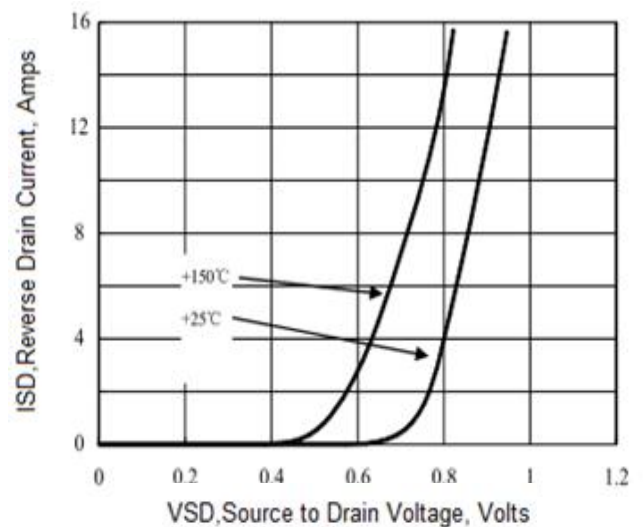
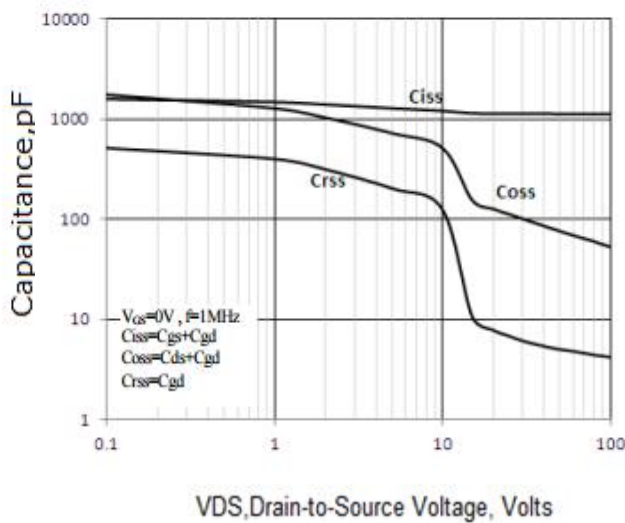
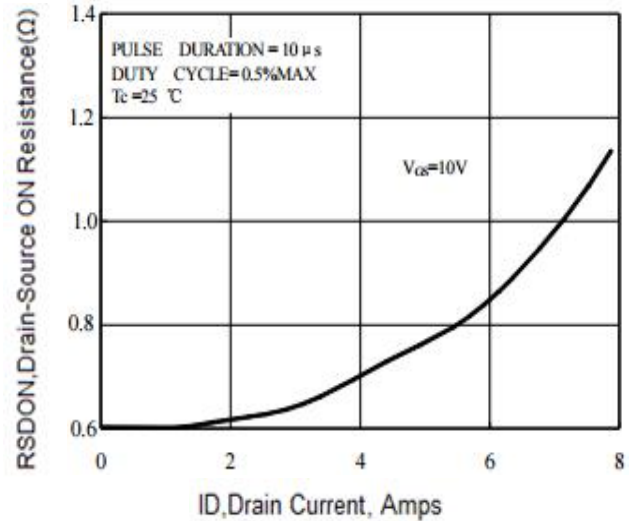
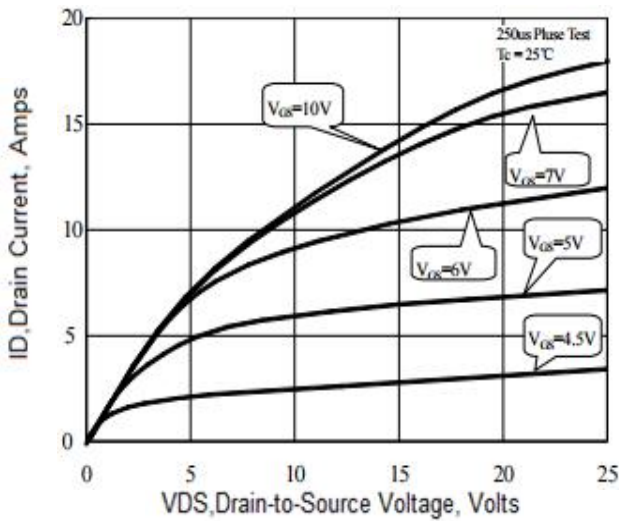
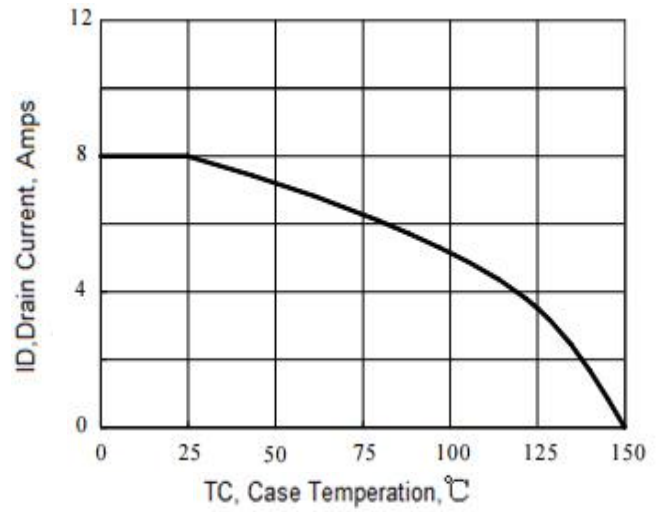
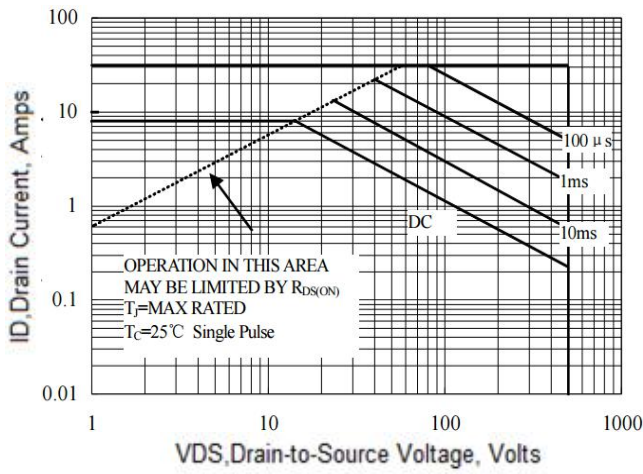
## 源-漏二极管特性参数:(除非特殊说明, $T_c=25^\circ\text{C}$ )

参数名称	测试条件	符号	最小值	典型值	最大值	单位
源极电流	MOS管中源极、漏极构成的反偏P-N结	$I_S$	-	-	8	A
源极脉冲电流(注 2)		$I_{SM}$	-	-	32	A
源-漏二极管压降	$I_{SD} = 8\text{ A}$ ,	$V_{SD}$	-	-	1.4	V
反向恢复时间(注 2)	$I_{SD} = 8\text{ A}$ , $V_{GS} = 0\text{ V}$ , $dI_F / dt = 100\text{ A}/\mu\text{s}$ ,	$trr$	-	340	-	nS
反向恢复电荷(注 2)		$Q_{rr}$	-	1.7	-	uC

(注:)

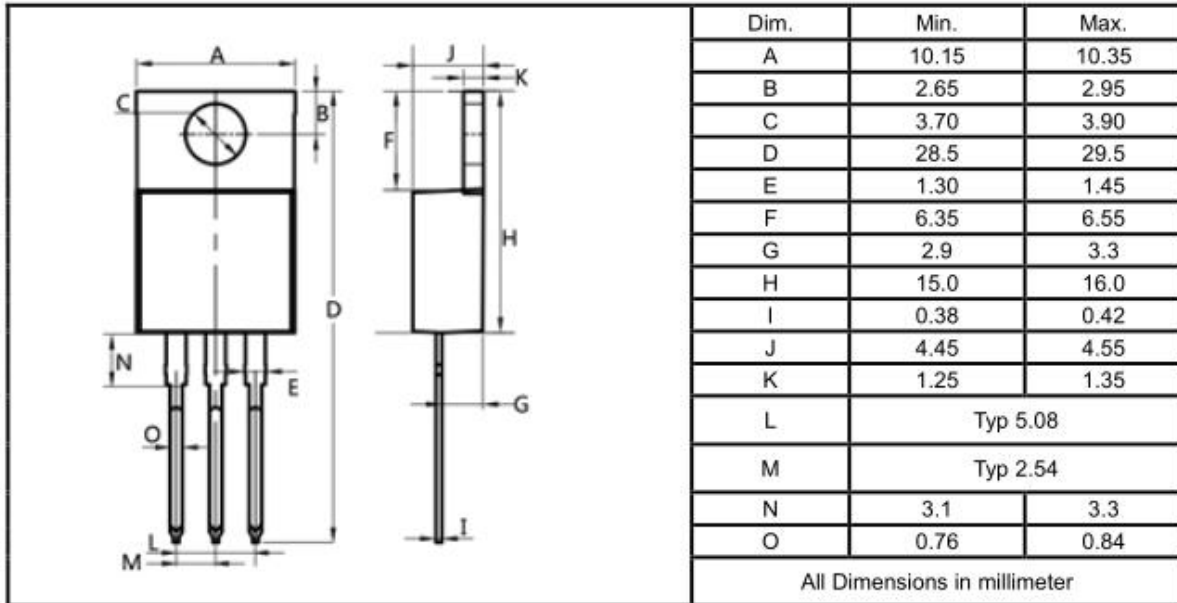
1. 脉冲测试: 脉冲宽度 $\leq 300\mu\text{s}$ , 占空比 $\leq 2\%$ ;
2. 基本上不受工作温度的影响。

典型特性区线图

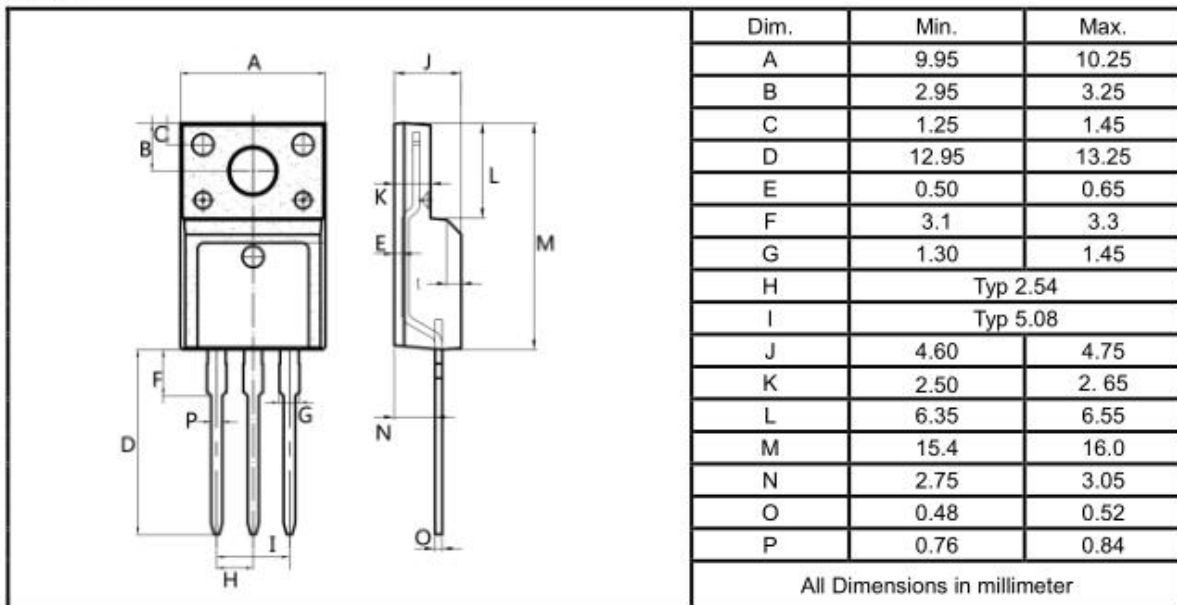


封装外型尺寸图

**TO-220AB**

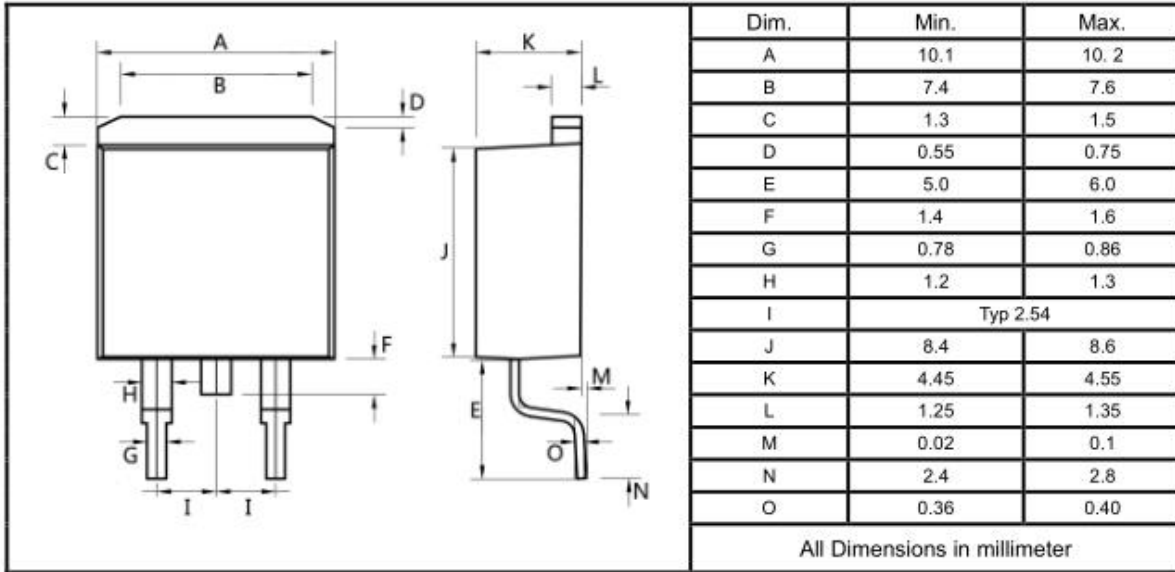


**TO-220F**

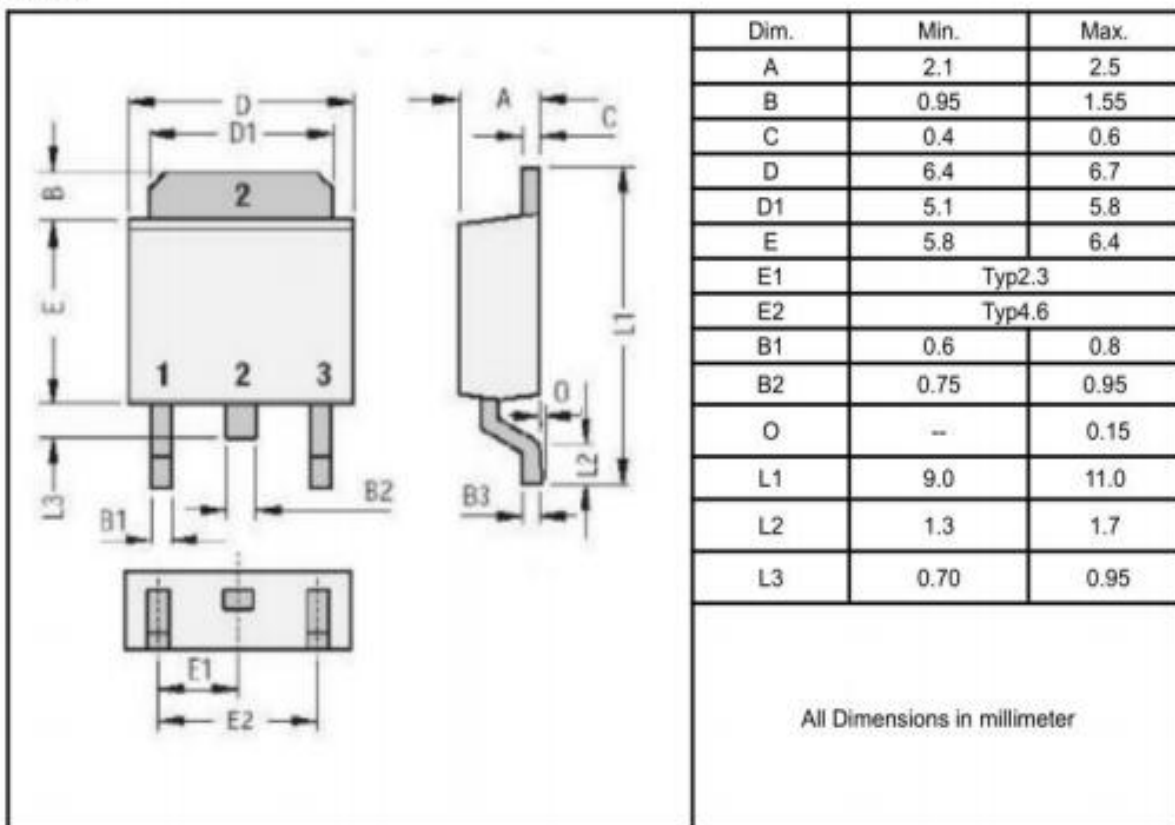


封装外型尺寸图

TO-263



TO-252



T0-251

